Формат	Зона	Поз.	0	δозн	аче	ние	Наименован	HUE	Кол.	Приме чани
							Документаци	я		
			ИУ4 ИУ	11.03.0	3 01.0	 1.00 Э1	Схема электриче	ская	1	
							структурная		•	
			ИУ4 ИУ	11.03.0	3 <i>02.0</i>		Схема электриче	ская	1	
							функциональная		-	
			ИУ4 ИУ	11.03.0	3 03.0	1.00 33	Схема электриче	ская	1	
							принципиальная			
			ИУ4 ИУ	11.03.0	3 04.0	3.00 ПЭЗ	Перечень элемені	тов	1	
			ИУ4 ИУ	11.03.0	3 05.0	3.00 34	Схема электриче		1	
							соединений			
			ИУ4 ИУ	11.03.0	3 06.0	3.00 ПЭ4	Перечень элемені	тов	1	
			ИУ4 ИУ	11.03.0	3 07.0	3.00	Чертеж печатной	Ī	1	
							платы			
			ИУ4 ИУ	11.03.0	3 08.0	8.00 СБ	Сборочный черте.	Ж	1	
							печатной платы			
			ИУ4 ИУ	11.03.0	3 10.0	7.00 M-УЛ	Плата печатная.		1	
							Данные элементо	β		
							структуры.			
							Информационно-			
							<i>Удостоверяющий</i>	лист.		
			ИУ4 ИУ	11.03.0	3 11.08	3.00 M-Y/I	Программное		1	
							оδеспечение			
							Информационно-			
							<i>Удостоверяющий</i>	лист.		
							Детали			
		1	ИУ4 ИУ	11.03.0	3 07.0	3.00	Плата печатная		1	
Изм.	. /Juc	m N	<u></u> Докум.	Подп.	Дата	ИУ 4	Н ИУ 11.03.0	3 09	.08	3.00
Раз _і Проі		-	Кудря А.А. Пеонидов В.В.			Электг	оонная ячейка	/lum.	Лист 1	Листов 5
Н.ко						•	ецификация	МГТ5 ка	<u>'</u> Гим. Б	аумана а ИУ4 У4-82

Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				Прочие изделия		
		2		Диод Шоттки	1	VD1
				MBR130LSFT1G; 1A; 30B;		
				φ. ON Semiconductor,		
				США; корпус SOD-123.		
		3		Индуктивность	1	L1
				LQG15HS27NJ02D;		
				ф. Murata, Япония;		
				27 нГн; 5%; корпус 0402.		
				Кнопочные		
				переключатели		
		4		Переключатель	1	SA1
				KLS7-SS-12F19-G5;		
				φ. KLS, Kumaū.		
		5		Кнопка тактовая	4	SB1-SE
				KLS7-TS6604-4.3-180;		
				φ. KLS, Kumaū.		
				<u>Конденсаторы</u>		
				керамические		
		6		GRM3165C1H220JD01D;	2	C5, C6
				ф. Murata, Япония;		
				22 πΦ; 50 B; 10%; X7R;		
				корпус 1206.		
		7		GRM31BR72J103K;	1	<i>C7</i>
				ф. Murata, Япония;		
				0,01 mκΦ; 50 B; 10%;		
				X7R; корпус 1206.		
			— Н ИЧД	4 ИУ 11.03.03 09.0	8	00

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. Nº подл. Подп. и дата

Форман	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
		8		GRM319R71H104K;	9	СЗ,
				ф. Murata, Япония;		C8-C10
				0,1 mκΦ; 50 B; 10%;		C12-C1
				X7R; корпус 1206.		
		9		GRM31MR71H105K;	1	<i>C</i> 4
				ф. Murata, Япония;		
				1 mκΦ; 50 B; 10%;		
				X7R; корпус 1206.		
		10		GRM31CR71E106KA12L;	1	<i>C11</i>
				ф. Murata, Япония;		
				10 ΜΚΦ; 50 B; 10%;		
				X7R; корпус 1206.		
				Конденсаторы		
				электролитические		
		11		TECAP, 0.1 mκΦ, 35B,	1	<i>C1</i>
				mun A, 10%, Kumaū.		
		12		TECAP, 10 MKΦ, 35B,	1	<i>C2</i>
				тип А, 10%, Китай.		
		13		Кварцевый резонатор	1	ZQ1
				HC-49SM-24 MF4;		
				Китай.		
				Микросхемы		
		14		Стабилизатор	1	DA1
				напряжения		
				MIC5201-3.3YS-0.2A;		
				корпус SOT-223;		
				ф. Microchip Technology,		
				США.		

Изм Лист № Докум. Ф2.104–2а.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп.

Дата

+ opridui	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
		15		Микросхема NEO-6M;	1	DD1
				ф. U-Blox, Швейцария		
		16		Микросхема	1	DD2
				STM32F100C8T6B;		
				φ. ST Microelectronics,		
+				Швейцария;		
				корпус LQFP-48.		
				Разъемы		
		17		Клеммник	1	XS1
1				KLS2-125-3.81-02P;		
1				ф. KLS, Kumaū.		
		18		Разъем U. FL-R-SMT-1;	1	XS2
				φ. Hirose Electric,		
				Япония.		
		19		Гнездо на плату 2,54мм	1	XS3
				1х4 прямое PBS-4;		
				φ. Ningbo connfly		
				electronic, Kumaū.		
		20		Гнездо на плату 2,54мм	1	XS4
				1х4 прямое PBS-8;		
				φ. Ningbo connfly		
				electronic, Kumaū.		
				<u>Резисторы</u>		
		21		RC1206FR-0710RL;	1	R3
				0,25 Вт;10 Ом; ±1%;		
				корпус 1206; Тайвань.		
		22		RC1206FR-0710KL;	1	R4-R8
\dashv				0,25 Bm; 10 κ0m; ±1%;		
				корпус 1206; Тайвань.		
\dashv						

Изм Лист № Докум. Ф2.104–2а.

Подп. и дата

Взам. инв. № | Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп.

Дата

Формат	Лоз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме чание
	23		RC1206JR-072K4L;	1	R1, R2
			0,25 Bm; 24 κ0m; ±1%;		
			корпус 1206; Тайвань.		
			Фильтр		
	24		BLM18RK121SN1D;	1	L2
			1200hm at 100MHz;		
			200mA; корпус 0603;		
			ф. Murata, Япония.		
+					
+					
_					
+					
+					
		141		00	<u> </u>
	Лист № До	кум. Подп. Дата	'4 ИУ 11.03.03 09.	UĞ.	00

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.